# Электрические, оптические и механические свойства аморфного гидрогенизированного углерода, полученного при различных условиях осаждения

© А.А. Бабаев<sup>¶</sup>, С.Б. Султанов, М.Ш. Абдулвагабов\*, Е.И. Теруков<sup>†</sup>

Институт физики Дагестанского научного центра Российской академии наук, 367003 Махачкала, Россия \* Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала, Россия

† Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 22 апреля 2010 г. Принята к печати 7 мая 2010 г.)

Исследованы энергия активации проводимости на постоянном токе, показатель преломления, микротвердость аморфных гидрогенизированных углеродных пленок a-C : H. Пленки были получены из метан-аргоновой смеси при различных условиях осаждения на кварцевые и кремниевые подложки: E/p = 40-180 В/мПа (E — напряженность электрического поля между электродами, p — давление газовой смеси в камере), температура подложки  $Ts = 50-300^{\circ}$  С. Эти условия осаждения позволяют получать алмазоподобные, полимероподобные, графитоподобные пленки a-C : H, в которых энергия активации проводимости, микротвердость и показатель преломления меняются в значительных пределах.

## 1. Введение

Интерес к аморфному гидрогенизированному углероду (a-C : H) объясняется уникальными свойствами этого материала, который в зависимости от условий получения могут изменяться от алмазоподобного до полимероподобного. Исследовано влияние кинетики процесса получения на оптические постоянные пленок a-C : H [1]. Экспериментально установлено, что повышению показателя преломления пленок a-C : H способствует увеличение напряжения на подложке [2], энергии ионов [3], плотности тока [4], содержания инертного газа в смеси с углеродом [5], скорости осаждения [6].

Показатель преломления (n) пленок на основе a-C : H, получаемых методом химического осаждения паров в плазме тлеющего разряда на постоянном токе [7], можно изменить от 1.5 до 2.4 на длине волны 0.63 мкм [8]. Одновременно с увеличением *п* наблюдаются уменьшение ширины оптической щели от 2.3 до 0.8 эВ [9], уменьшение удельного сопротивления от  $\sim 10^{13}$ до  $\sim 10^7 \, {\rm Om} \cdot {\rm cm}$ , рост поглощения пленок в видимой области спектра [10]. Благодаря сочетанию химической стойкости, механической и лучевой прочности с прозрачностью в инфракрасной области спектра алмазоподобные пленки а-С:Н могут быть использованы в качестве защитных покрытий для инфракрасной оптики, в частности для медных зеркал [11]. Эти пленки были использованы в качестве ориентирующих слоев для жидких кристаллов [12]. Черные пленки a-С : H с  $n \approx 2$ , поглощающие свет в видимой области спектра, применяются как светоблокирующие слои в модуляторах света отражательного типа на жидких кристаллах [13]. Анализ инфракрасных спектров многократного нарушенного полного внутреннего отражения пленок *a*-C: H [14] показал, что характерной особенностью инфракрасных спектров пленок *a*-C : H с  $n \ge 2.0$  является присутствие полосы при ~ 1250 см<sup>-1</sup>, соответствующей валентным колебаниям C–C-связей в функциональных узлах с четверным разветвлением структуры, которая практически отсутствует в спектрах пленок *a*-C : H с  $n \le 1.6$ . Все эти результаты получены на пленках с шириной оптической щели  $\lesssim 2.3$  эВ, которые в основном осаждались при температуре подложки ~  $(20-50)^{\circ}$ C из паров жидких и газообразных углеводородов толуола, циклогексана, бензола, октана, ацетилена и его смеси с аргоном. Установлено существенное различие значений оптических постоянных пленок *a*-C : H, полученных из различных источников сырья [1].

Цель настоящей работы — исследование показателя преломления (n), энергии активации проводимости  $(E_a)$ , микротвердости (H) пленок a-C : H, полученных из метан-аргоновой смеси при различных условиях осаждения: различные соотношения E/p (E — напряженность электрического поля между электродами, p — давление газовой смеси в камере) и температуры подложки  $(T_s)$ . Используемые условия осаждения позволяют получать пленки a-C : H различной модификации с шириной запрещенной зоны  $E_g = 4.5$  эВ, при коэффициенте поглощения  $\alpha = 10^4$  см<sup>-1</sup>[15,16].

#### 2. Методика эксперимента

Пленки *a*-C: Н получены методом плазмохимического газофазного разложения смеси 10%CH<sub>4</sub> + 90%Ar в плазме тлеющего разряда емкостного типа при различных условиях осаждения: на кварцевые и кремниевые подложки с температурой  $T_s$  от 50 до 300°C и при соотношении E/p, изменявшемся от 40 до 180 В/мПа. Толщина пленок *a*-C: Н, наносимых в течение 40–60 мин, соответствовала 0.6–1 мкм. Время пребывания молекул

<sup>¶</sup> E-mail: Gamzatov\_adler@mail.ru

в разрядном промежутке составляло t = 3 с. Толщину пленки a-C : H и n определяли как по спектрам пропускания, так и с помощью эллипсометра ЛЭФ-2 на длине волны  $\lambda = 0.63$  мкм по специально рассчитанным номограммам. Для всех пленок a-C : H были измерены температурные зависимости электропроводности на постоянном токе, определены значения энергии активации  $E_a$ . На образцы напыляли контакты в виде полос металла NiCr или Mo, с зазором 1.5 мм между ними. Содержание водорода в a-C : H определялось по инфракрасным спектрам поглощения и составляло 10–25%. Измерения микротвердости H пленок a-C : H выполнены с использованием алмазной пирамиды Виккерса [17].

### 3. Экспериментальные результаты

На рис. 1 приведены результаты исследования *n* и *H* пленок а-С: Н, полученных при различных температурах подложки и постоянном отношении E/p = 90 В/мПа. Величина *п* пленок увеличивается от  $\sim 1.5$  до 2.4 с ростом  $T_s$  от 50 до 300°С, одновременно увеличивается H, достигая максимума при  $T_s \approx 220^{\circ}$ С. В пленках a-С : Н, полученных при  $T_s \ge 220^{\circ}$ С, величина *H* уменьшается. Хрупкие пленки, которые имеют  $2.4 \ge n > 1.8$  и большую микротвердость, можно условно отнести к алмазоподобным, в то время как пленки, для которых n < 1.8, можно отнести к полимероподобным. Уменьшение Н пленок *a*-C : H, полученных при  $T_s > 220^{\circ}$ C, приводит к образованию и росту графитоподобной фазы. Эти пленки оказались черными. Структура этих пленок исследована с помощью инфракрасной спектроскопии [18]. В пленках а-С: Н наблюдаются три моды валентных колебаний: CH<sub>2</sub> (2920 см<sup>-1</sup>) и CH<sub>3</sub> (2860, 2950 см<sup>-1</sup>). В области деформационных колебаний наблюдаются соответствующие полосы 1450 см<sup>-1</sup> (CH<sub>2</sub>) и 1375 см<sup>-1</sup> (CH<sub>3</sub>). Эти колебания соответствуют углероду в тетраэдрической конфигурации  $sp^3$ . В области 3050 см<sup>-1</sup> различима



**Рис. 1.** Зависимости показателя преломления n(1) и микротвердости H(2) пленок a-С : Н от температуры подложки  $(T_s)$  при постоянном E/p = 90 В/мПа.

Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 1



**Рис. 2.** Зависимости показателя преломления n (1) и микротвердости H (2) пленок a-C : H от отношения E/p при постоянной  $T_s = 220^{\circ}$ C.

слабая полоса валентных колебаний CH<sub>2</sub> или CH-групп, где углерод находится в  $sp^2$ -конфигурации. При увеличении  $T_s$  от 220 до 300°C (при E/p = 90 В/мПа) полоса валентных колебаний (3050 см<sup>-1</sup>) становится более заметной. Это означает, что углерод находится в основном в  $sp^3$ -конфигурации. Пленки a-C : H с  $n \ge 2$  и более можно отнести к алмазоподобным. Полимероподобные пленки a-C : H отличаются от алмазоподобных бо́льшим содержанием связанного водорода.

Другим подходом к решению управления параметрами *n* и *H* пленок *a*-C : Н является изменение отношения E/p при постоянной  $T_s$ . Изменение технологического параметра E/p от 40 до 180 В/мПа при  $T_s = 220^{\circ}$ С приводит к росту *n* от ~ 1.6 до 1.9 (рис. 2). Зависимость *H* от E/p имеет максимум при E/p = 90 В/мПа. Увеличение отношения до E/p > 90 В/мПа приводит к уменьшению *H* пленок *a*-C : Н. Пленки темнеют, образуется графитоподобная фаза. Особый интерес представляют результаты исследования  $E_a$  пленок *a*-C : H в зависимости от  $T_s$  и E/p. Для всех пленок *a*-C : H, полученных при различных технологических параметрах, наблюдается единый активационный закон температурной зависимости электропроводности

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/kT),$$

где T — температура, k — постоянная Больцмана. Экспериментально было проверено, являются ли Е и р независимыми параметрами процесса или же отношение Е/р определяет процесс и, следовательно, свойства пленок. Исследовали зависимости E<sub>a</sub> от T<sub>s</sub> при различных значениях р, поддерживая постоянным Е. При различных значениях  $T_s$  и t с ростом p увеличивается  $E_a$ . В пленках, полученных при постоянных  $T_s$ , t и при различных значениях E, p, но постоянном отношении E/p, наблюдаются одинаковые значения Еа и п. Увеличение  $T_s$  пленок *a*-C : H от 50 до ~ 220°C приводит к росту  $E_a$ от 1.3 до 2 эВ. Пластичные пленки а-С: Н становятся хрупкими. В пленках, полученных при  $T_s > 220^{\circ}$ С, Еа уменьшается до 0.4 эВ (рис. 3). При этом пленки темнеют, в них образуется графитоподобная фаза. Изменения отношения E/p от 40 до 90 В/мПа приводит



**Рис. 3.** Зависимость энергии активации проводимости  $E_a$  пленок a-C : H от температуры подложки  $T_s$  при постоянном E/p = 90 В/мПа.



**Рис. 4.** Зависимость энергии активации проводимости  $E_a$  пленок *a*-C : Н от отношения E/p при постоянной температуре  $T_s = 220^{\circ}$ C.

к росту  $E_a$  от ~ 1.8 до 2 эВ, при дальнейшем росте E/p до 180 В/мПа  $E_a$  уменьшается до 1 эВ (рис. 4). При низких значениях отношения, E/p < 90 В/мПа, пленки становятся пластичными, а при  $E/p \gg 90$  В/мПа пленки *a*-C : Н — графитоподобные.

#### 4. Заключение

Обобщены и систематизированы результаты исследования показателя преломления n, микротвердости H и энергии активации проводимости  $E_a$  пленок a-C : H, полученных из метан-аргоновой смеси в плазме тлеющего разряда при различных условиях осаждения: различные отношения E/p и  $T_s$ . Изменение отношения E/p и  $T_s$  позволяет варьировать структуру и свойства пленок a-C : H, получая алмазоподобные, полимероподобные и графитоподобные пленки. Полученные результаты представляют интерес для решения прикладных задач в области физики с использованием тонких пленок a-C : H.

#### Список литературы

- [1] Е.А. Коншина, В.А. Толмачев. ЖТФ, 65 (1), 175 (1995).
- [2] A. Bulenzer, D. Dischler, G. Brant. J. Appl. Phys., 54 (8), 4590 (1983).
- [3] R. Locher, C. Wild, R. Koide. Surf. Coat. Tech., 47, 426 (1991).
- [4] K. Fujii, N. Shohota, M. Mikami. Appl Phys. Lett., 47 (4), 370 (1985).
- [5] В.Б. Яковлев, Л.К. Васильева, Е.А. Коншина. ЖПС, 53 (5), 863 (1990).
- [6] Р. Аззам, Н. Башара. Элипсометрия и поляризованный свет (М., Мир, 1981).
- [7] Е.А. Коншина. ЖТФ, 2 (6), 35 (2002).
- [8] V.A. Tolmachev, E.A. Konshina. Diamond Relat. Mater., 5, 1397 (1996).
- [9] Е.А. Коншина. ФТТ, 37, 1120 (1995).
- [10] Е.А. Коншина. ЖТФ, 70 (3), 87 (2000).
- [11] Е.А. Коншина. ЖТФ, 68 (9), 59 (1998).
- [12] Е.А. Коншина. Кристаллография, 40, 1074 (1995).
- [13] Е.А. Коншина, А.П. Онохов. ЖТФ, 69 (3), 80 (1999).
- [14] Е.А. Коншина, А.И. Вангонен. ФТП, **39** (5), 616 (2005).
- [15] А.А. Бабаев, М.Ш. Абдулвагабов. Письма ЖТФ, 15 (14), 75 (1989).
- [16] А.А. Бабаев, И.К. Камилов, С.Б. Султанов, А.М. Асхабов. ФХС, **31** (3), 436 (2005).
- [17] И.П. Маника, Я.Е. Манинс, А.Я. Тетерис. Изв. АН ЛатвССР. Сер. физ. и техн. наук, № 6, 34 (1986).
- [18] М.Ш. Абдулвагабов, Б.А. Билалов, Г.К. Сафаралиев. Тр. 8-й Межд. конф. "Пленки и покрытия — 2007" (СПб., 2007) с. 63.

Редактор Л.В. Шаронова

# Electrical, optical and mechanical properties of amorphous hydrogenated carbon obtained under different conditions of deposition

A.A. Babaev, S.B. Sultanov, M.Sh. Abdulvagabov\*, E.I. Terukov<sup>†</sup>

Amirkhanov Institute of Physics, Daghestan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, 367003 Makhachkala, Russia \* Daghestan State University, 367003 Makhachkala, Russia † loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St.Petersburg, Russia

**Abstract** Conductivity activation energy at direct current, refractive index and microhardness of amorphous hydrogenated carbon films *a*-C : H were studied. The films were obtained from methane–argon mixture on quartz depositon and silicon substrates under different deposition conditions: E/p = 40-180 V/mPa (*E* is electric field between electrodes, *p* is pressure of gas mixture in the cell) and substrate temperature  $T_x = 50-300^{\circ}$ C. These deposition conditions allow to obtain diamond-like, polymer-like, and graphite-like *a*-C : H films, where conductivity activation energy, microhardness and refractive index change in considerable ranges.